

## 三相无刷电机预驱电路 PMOS+NMOS

### 功能描述

HM8324 内部包含 3 路 NMOS 功率管驱动电路、3 路 PMOS 功率管驱动电路。电路内部集成了 78L05 三端稳压器，可提供稳定的 5V 输出电源。

HM8324 最高可工作在 36V，极限耐压为 65V。在工作电压为 24V 时，内部控制电路可使 PMOS 功率管开启时的栅极电压为 12V 左右（即 PMOS 功率管的  $V_{GS}$  电压约为 -12V）。

HM8324 可实现 NMOS、PMOS 的快速导通关断，延迟、导通关断时间均在 400ns 以内（负载电容为 1nF 条件下）。

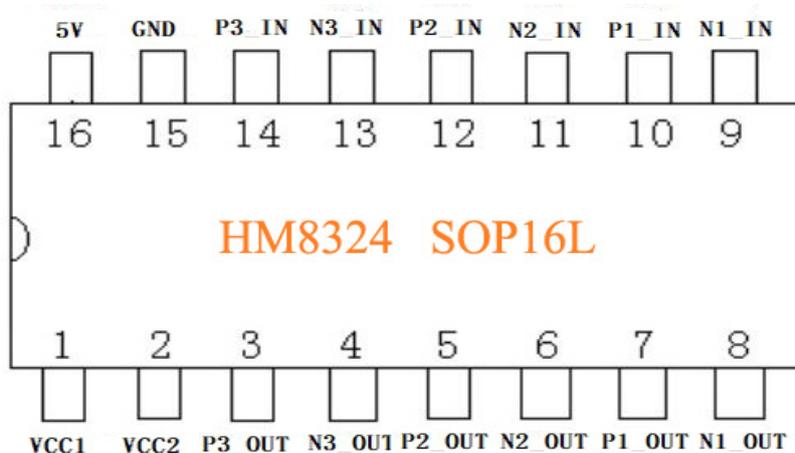
### 特性

- 低待机电流：0.9mA@12V/1.1mA@24V
- 工作电压范围：12V~36V
- 开关速度快:<400ns @ $C_{Load}=1nF$
- 可直接驱动 PMOS+NMOS 功率管
- 集成稳压源：5V
- 抗静电能力:2KV（HBM）
- 工作温度范围：-20°C~+80°C
- 内置保护电路：过温保护（TSD）、过流保护（OCP）

### 典型应用

- 三相电机 PMOS、NMOS 功率管驱动

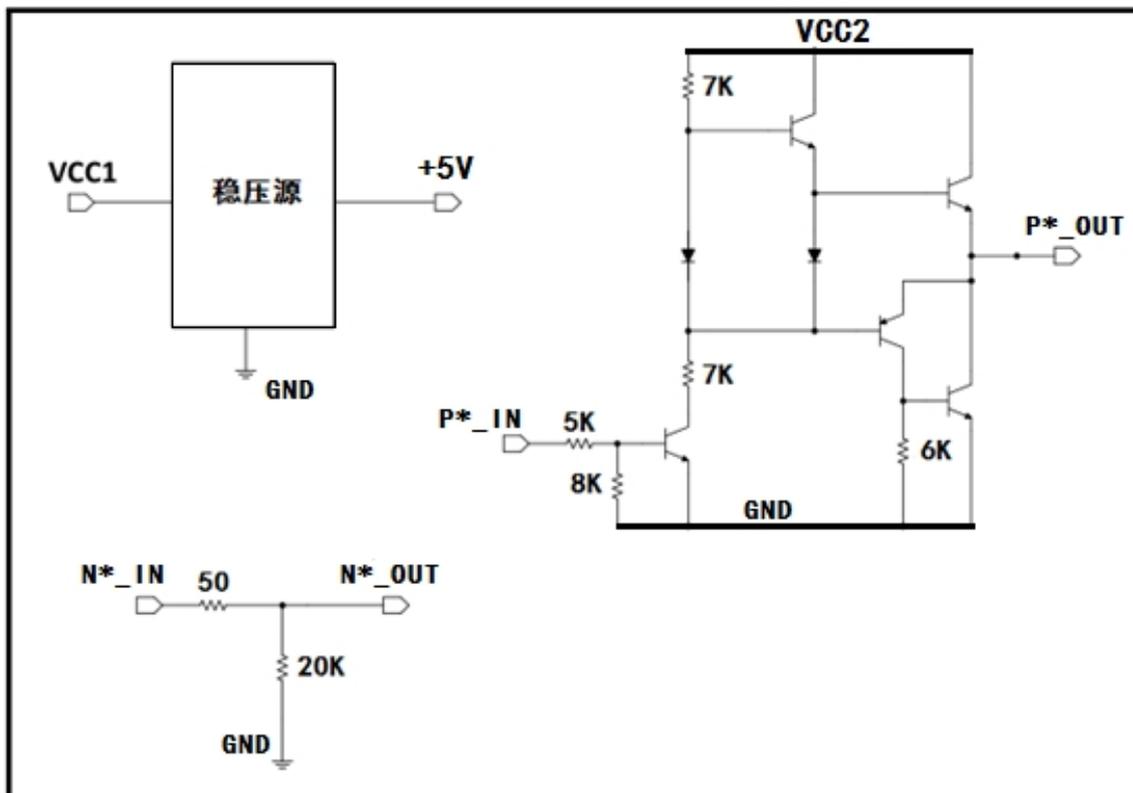
### 引脚排列（SOP16L）



引脚定义

引脚编号	引脚名称	输入/输出	引脚功能描述
1	VCC1	-	稳压源的电源
2	VCC2	-	驱动电路电源
3	P3_OUT	O	通道 3 PMOS 输出
4	N3_OUT	O	通道 3 NMOS 输出
5	P2_OUT	O	通道 2 PMOS 输出
6	N2_OUT	O	通道 2 NMOS 输出
7	P1_OUT	O	通道 1 PMOS 输出
8	N1_OUT	O	通道 1 NMOS 输出
9	N1_IN	I	通道 1 NMOS 输入
10	P1_IN	I	通道 1 PMOS 输入
11	N2_IN	I	通道 2 NMOS 输入
12	P2_IN	I	通道 2 PMOS 输入
13	N3_IN	I	通道 3 NMOS 输入
14	P3_IN	I	通道 3 PMOS 输入
15	GND	-	接地
16	5V	O	稳压源输出 (+5V)

内部逻辑框图



## 逻辑真值表

N*_IN	N*_OUT
悬空	L
L	L
H	H

P*_IN	P*_OUT
悬空	H
L	H
H	L

注：\*代表通道 1、2、3。

## 绝对最大额定值

(TA=25°C，除另有规定外)

参 数	符 号		范 围			单 位
			最 小	典 型	最 大	
电源电压	VCC1		6.5	-	65	V
	VCC2		6.5	-	65	V
输入频率	F <sub>in</sub>		-	-	100	KHz
θ <sub>JA</sub> 封装热阻抗	θ <sub>JA</sub>	SOP16	-	-	160	°C/W
功耗	P <sub>D</sub>	SOP16	-	-	625	mW
最高工作结温	T <sub>J</sub>		-	-	150	°C
焊接温度			-	-	260	°C, 10S
储存温度范围	T <sub>stg</sub>		-65	-	150	°C

注：最大功耗可按照下述关系计算

$$P_D = (T_J - T_A) / \theta_{JA}$$

T<sub>J</sub>表示电路工作的结温温度，T<sub>A</sub>表示电路工作的环境温度。封装热阻的计算方法按照JESD 51-7。

## 电特性参数表

## ①稳压源（如无特别说明, VDD1=12V, TA=25°C）

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I <sub>VDD</sub> 静态电流	VCC1=12V	0.8	0.85	0.9	mA
V <sub>O</sub> 稳压源输出电压	6.5V ≤ V <sub>I</sub> ≤ 36V 1mA ≤ I <sub>O</sub> ≤ 30mA	4.8	5	5.2	
ΔV <sub>OI</sub> 稳压源线性调整率	6.5V ≤ V <sub>I</sub> ≤ 30V		32	150	mV
ΔV <sub>OL</sub> 稳压源负载调整率	1mA ≤ I <sub>O</sub> ≤ 100mA		15	60	
	1mA ≤ I <sub>O</sub> ≤ 40mA		8	30	
T <sub>OTP</sub> 稳压源过温保护			150		°C

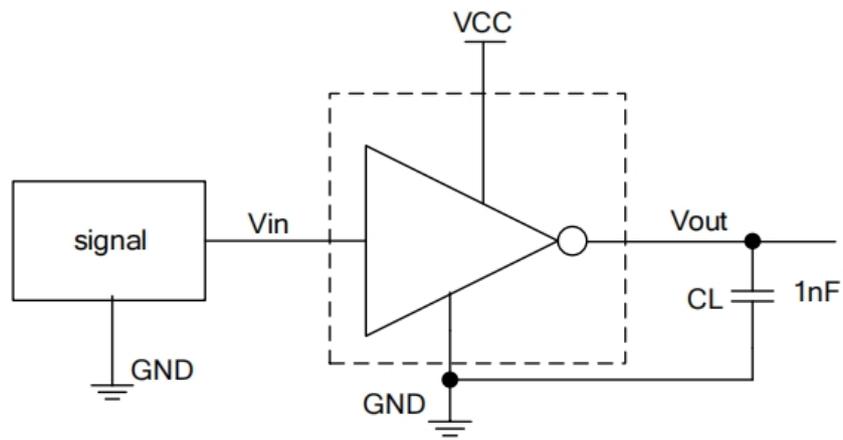
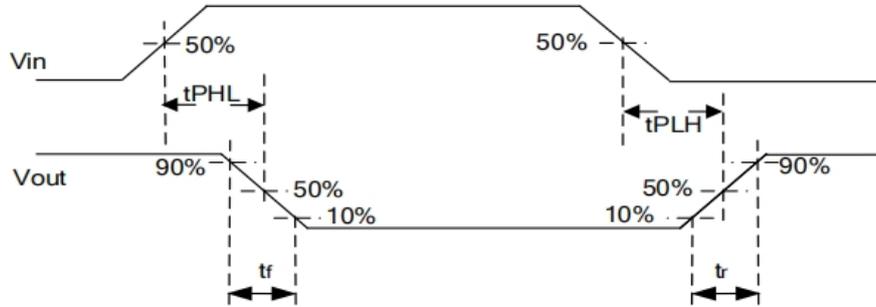
## ②驱动 PMOS 功率管（如无特别说明, VDD2=24V, TA=25°C）

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I <sub>in</sub> P*_IN输入电流	V <sub>P*_IN</sub> =5V	0.7	0.9	1.1	mA
V <sub>OH</sub> 输出高电平	VCC=16~30V, 空载	VDD-1.5	-	-	V
V <sub>OL</sub> 输出低电平	VCC=16~30V, 空载	-	0.5*VDD	-	
t <sub>PHH</sub> 上升沿延时	VCC2=24V, 空载	-	75	150	ns
t <sub>PLL</sub> 下降沿延时		-	75	150	
t <sub>r</sub> 上升沿	VCC2=24V, CL=1nF	-	100	300	
t <sub>f</sub> 下降沿	VCC2=24V, CL=1nF	-	100	300	

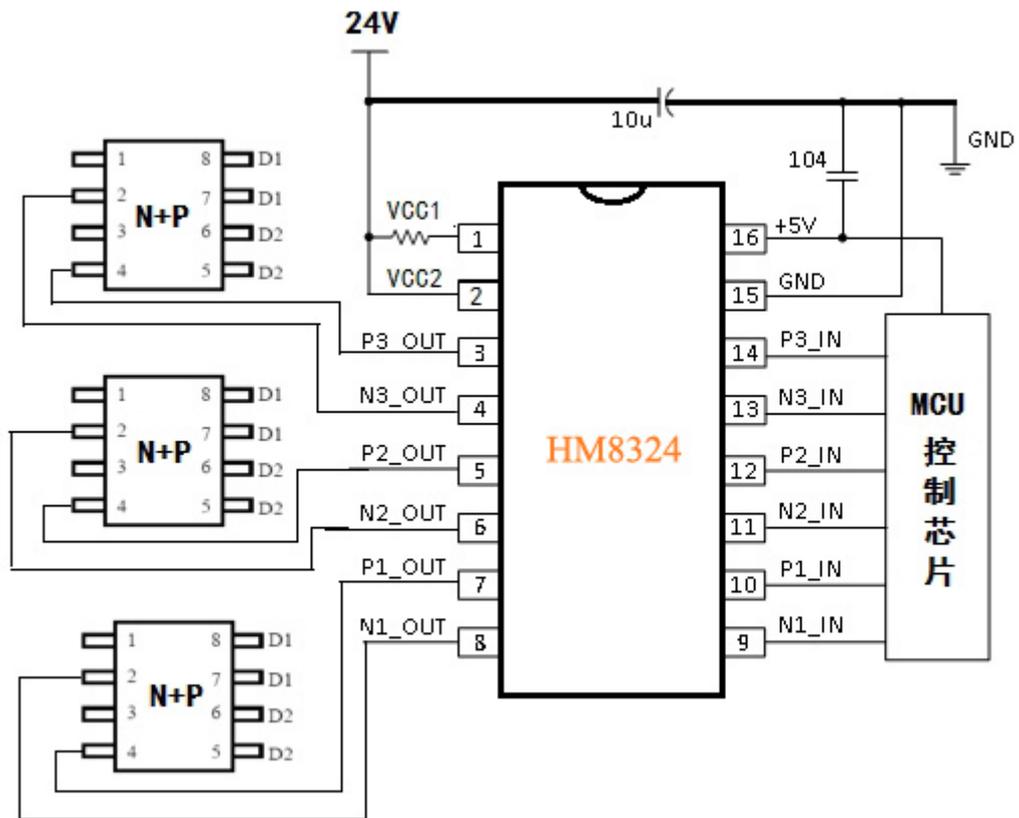
## ③驱动 NMOS 功率管（如无特别说明, VCC2=24V, TA=25°C）

参数	最小值	典型值	最大值	单位
输入电阻	40	50	60	Ω
下拉电阻	14.4	18	21.6	KΩ

时间参数测试说明



典型应用电路图



封装形式: SOP16L

